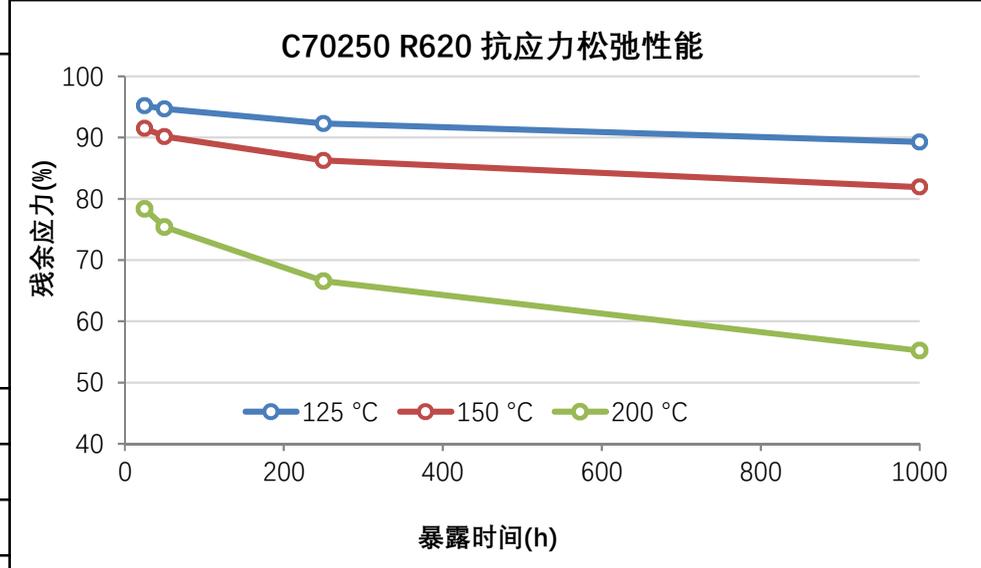


4.8 CuNi3Si - C70250

| 应用范围 | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----|------------------------|------------------------|
| 连接器, 折弯件, 继电器 | | | | | | | | |
| 物理性能 | | | | | | | 化学成分 (参考值) % | |
| 密度 * | | 克/厘米 ³ | | 8.8 | | 铜 | | min. 96.2 |
| 导热性 * | | 瓦/(米·开) | | 190 | | 镍 | | 2.2 - 4.2 |
| 导电率 *** | | 毫西门子/米 | | 23 | | 硅 | | 0.25 - 1.2 |
| 导电率 *** | | IACS (%) | | 40 | | 镁 | | 0.05 - 0.30 |
| 热膨胀系数 ** | | 10 ⁻⁶ K | | 17.6 | | 其他 | | 余量 |
| 弹性模量 * | | 千兆帕 | | 130 | | | | |
| 状态 | 强度等级 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 硬度 | 导电性 | 弯曲性能 | |
| | | T.S. 最小值-最大值 兆帕 | Rp 0.2 最小值 兆帕 | A50 最小值 % | (参考值) 维氏硬度 | | 好的方向 铜带厚度 ≤0.5mm | 坏的方向 铜带厚度 ≤0.5mm |
| 沉淀强化 | R620 | 620 - 760 | 500 | 10 | 180 - 240 | 23 | 0 | 0 |
| 沉淀强化 | R655 | 655 - 825 | 585 | 7 | 190 - 250 | 23 | 1 | 1 |
| 沉淀强化 | R690 | 690 - 860 | 655 | 5 | 220 - 260 | 23 | 1.5 | 1.5 |
| 沉淀强化 | R750 | 750 - 860 | 700 | 4 | 230 - 260 | 23 | 2 | 2 |



*室温下的参考值

**温度范围 20 - 300°C

*** 最低强化状态下的数值

¹⁾ $r = x \cdot t$ (适用于铜带厚度 $t \leq 0.5\text{mm}$)

²⁾ 样品宽度=10mm/可以根据要求在更窄的宽度进行弯曲测试 (评估方法依据手册5.4.2页)

免责声明：由于生产工艺可能对更改及差异，本手册及数据表上公布的信息不能保证。本公司保留更改、修订上述内容的权利。因所提供的信息造成的任何问题，本公司不承担责任。